**中国科学院半导体研究所“青年创芯奖”申请表2023**

**注1: 填写入所以来的项目和成果，确保内容不超过1页。**未填行可删除**。**

**注2: 所有项目和成果都须提供简单证明材料供审核，**例如成果首页或证据页面**。**

|  |  |
| --- | --- |
| 科研诚信承诺 | 本人已仔细阅读简表各项内容要求。承诺以下所填写的内容真实准确。我愿意接受研究所对申报材料的审核。 申请人: 推荐部门 负责人签字（推荐意见）:  |
|  |
| 姓 名 |  | 出生年月 | YYYY.MM | 入所时间 | YYYY.MM | 所在部门 |  |
| 最高学位 |  | 毕业院校 |  | 职称 |  | 专业方向 |  |
| 邮 箱 |  | 联系电话 |  |
| **1、入所以来，基于半导体所平台所取得的个人成果简介**(限500字以内，五号字11行) |
|  |
| **2、入所以来，以半导体所作为依托单位所承担的代表性科研项目情况** |
| 2.1 填写不超过5项且**合同书（或任务书）明确的**以项目负责人A或课题负责人B或参与者C身份承担对外争取的科技任务情况。敏感项目请使用ARP名称，项目来源标注“高技术”。 |
| ARP号 | 项目来源类别 | 项目名称 | 起止年 | 角色 | **留所经费** |
|  |  |  | **YYYY-MM** | 选项 |  |
|  |  |  |  | 选项 |  |
|  |  |  |  | 选项 |  |
|  |  |  |  | 选项 |  |
|  |  |  |  | 选项 |  |
| 1. **入所以来，以半导体所作为完成单位的个人代表性成果，论文和其他成果，数量可增减，总共不超过10项。**
 |
| 3.1 代表性论文。作者身份：唯一一作或唯一通讯A1、共同一作或共同通讯A2、其他情况B |
| 序号 | 题目 | 期刊名称(可WOS标准缩写) | 发表年份 | 作者身份 | DOI |
| 1) |  |  |  | 选项 |  |
| 2) |  |  |  | 选项 |  |
| 3) |  |  |  | 选项 |  |
| 4) |  |  |  | 选项 |  |
| 5) |  |  |  | 选项 |  |
| 6) |  |  |  | 选项 |  |
| 3.2除学术论文外的其他成果和奖励，如专利、邀请报告、专著、获奖等，合作成果请注明自己贡献。 |
| **序号** | 成果类别 | 成果和奖励相关信息 | 依托单位 | 产出年份 | 排名或贡献 |
| 1) |  |  | 选项 |  |  |
| 2) |  |  | 选项 |  |  |
| 3) |  |  | 选项 |  |  |
| 4)注：入所时间包含我所博士后在站时间，不包含研究生在读时间 |  |  | 选项 |  |  |